



2SB893 (3CG893)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途：用于电源, 继电器驱动, 灯驱动, 闪光驱动。

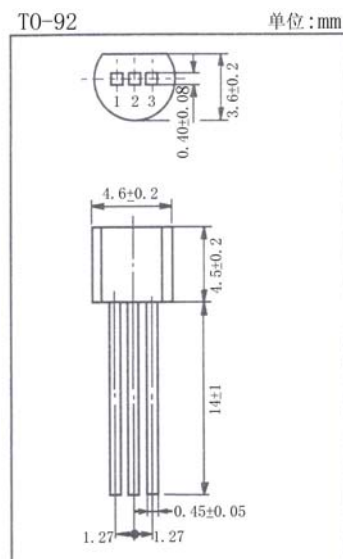
Purpose: Power supplies, relay drivers, lamp drivers, strobes.

特点：饱和压降低, 电流容量大, 安全工作区宽。

Features: Low saturation voltage, large current capacity and wide ASO.

极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-20	V
V_{CE0}	-10	V
V_{EB0}	-7.0	V
I_C	-2.5	A
$I_C(\text{Pulse})$	-5.0	A
P_C	750	mW
T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$



引脚: 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=-10\mu\text{A}$ $I_E=0$	-20			V
V_{CE0}	$I_C=-1.0\text{mA}$ $R_{BE}=\infty$	-10			V
V_{EB0}	$I_E=-10\mu\text{A}$ $I_C=0$	-7.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-20\text{V}$ $I_E=0$			-1.0	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-4.0\text{V}$ $I_C=0$			-1.0	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-500\text{mA}$	100		560	
$*h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-2.0\text{V}$ $I_C=-3\text{A}$	70			
$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=-1.5\text{A}$ $I_B=-150\text{mA}$		-0.25	-0.45	V
f_T	$V_{CE}=-10\text{V}$ $I_C=-50\text{mA}$		250		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$ $f=1.0\text{MHz}$		70		pF

*:pulse test/脉冲测试。

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ classifications: E: 100~200 F: 160~320 G: 280~560

